Мессбауэровское исследование двухэлектронной акцепторной примеси цинка в кремнии

© Ф.С. Насрединов, Н.П. Серегин, П.П. Серегин, С.И. Бондаревский

Санкт-Петербургский государственный технический университет, 195251 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 20 сентября 1999 г. Принята к печати 12 октября 1999 г.)

Методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии на изотопе 67 Ga(67 Zn) показано, что двухэлектронная акцепторная примесь цинка в кремнии в зависимости от положения уровня Ферми присутствует только в виде нейтральных $[Zn]^0$ и двукратно ионизованных $[Zn]^=$ центров, причем уширение спектров, отвечающих указанным центрам, свидетельствует об отличии их локальной симметрии от кубической. Отсутствие в мессбауэровских спектрах частично компенсированных образцов однократно ионизованного состояния $[Zn]^=$ рассматривается как доказательство отрицательного знака корреляционной энергии.

Примесные атомы цинка в кремнии являются акцепторами и образуют в запрещенной зоне два глубоких энергетических уровня [1,2]. Предполагается, что при высоких температурах цинк диффундирует по междоузлиям, а при охлаждении образца цинк стабилизируется преимущественно в узлах решетки, причем концентрация электрически активного цинка практически совпадает с общей концентрацией цинка [1]. Считается, что примесные атомы цинка образуют в кремнии двухэлектронные акцепторные центры с энергиями ионизации $E_1 \sim 0.31$ эВ [процесс (0/-)] и $E_2 \sim 0.55$ эВ [процесс (-/-)] [2], так что цинк в зависимости от положения уровня Ферми может стабилизироваться в трех зарядовых состояниях: нейтральном $[Zn]^0$, однократно $[Zn]^-$ и двукратно $[Zn]^-$ и онизованном.

Первые попытки обнаружить спектр электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) парамагнитных центров [Zn] в кремнии не были успешными [3]. Авторы [4] таким центрам приписали спектр ЭПР, измеренный для образцов кремния, легированных цинком и находящихся под одноосным сжатием. Однако полная идентификация спектров не была проведена. Позднее авторы [5] сообщили о существовании в кремнии, легированном цинком, двух спектров ЭПР, появляющихся только в процессе подсветки высокоомных дырочных образцов белым светом. Один из этих спектров был связан с центрами [Zn] - с орторомбической симметрией [6]. В связи с таким поведением спектров ЭПР было предположено, что двухэлектронный акцепторный центр цинка в кремнии имеет отрицательную корреляционную энергию U: последовательность его уровней инвертирована (для процессов (0/-) и (-/--) энергии термической ионизации равны соответственно $E_1 = 0.316 \, \mathrm{9B}$ и $E_2 = 0.167 \, \mathrm{эB}$); центры $[\mathrm{Zn}]^-$, $[\mathrm{Zn}]^-$ и $[\mathrm{Zn}]^0$ находятся в разных положениях решетки кремния (они являются центрами замещения, однако смещены относительно невозмущенного узла, так что симметрия этих центров является соответственно C_{3V} , C_{2V} и D_{2d}); из-за отрицательного знака U центр $[\mathrm{Zn}]^-$ оказывается нестабильным и спонтанно распадается по реакции $2[Zn]^- \rightarrow [Zn]^0 + [Zn]^= [6,7].$

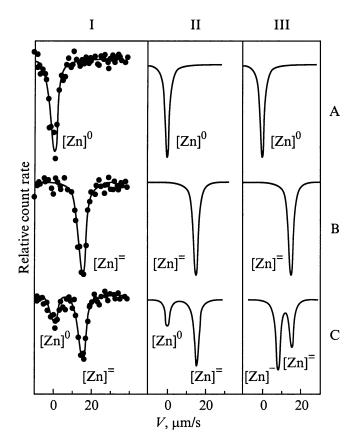
Очевидно, что для выбора между двумя возможными моделями акцепторной примеси цинка в кремнии (U > 0 [2] или U < 0 [6,7]) необходима идентификация центров $[Zn]^0$ и $[Zn]^=$, определение симметрии их локального окружения, а также экспериментальное определение соотношения концентраций этих центров в зависимости от положения уровня Ферми. В связи с этим актуальным представляется исследование поведения примесных атомов цинка в кремнии методом эмиссионной мессбауэровской спектроскопии на изотопе 67 Ga(67 Zn): диффузионное введение изотопа 67 Ga в кремний гарантирует стабилизацию как материнского ⁶⁷Ga, так и дочернего 67Zn атомов в положении замещения; варьирование концентрации носителей в исходных образцах кремния позволяет управлять положением уровня Ферми и получать материал с контролируемым соотношением концентраций зарядовых состояний цинка; параметры мессбауэровских спектров ⁶⁷Zn позволяют надежно определять зарядовое (электронное) состояние атомов цинка, симметрию их локального окружения и соотношение концентраций между различными зарядовыми состояниями цинка.

Радиоактивный изотоп 67 Gа готовили по реакциям 67 Zn $(p,n)^{67}$ Gа и 66 Zn $(d,n)^{67}$ Gа с последующим хроматографическим выделением безносительного препарата. Легирование кремния галлием 67 Gа проводилось методом диффузии в вакуумированных кварцевых ампулах из газовой фазы при 1320° C в течение 5 ч (глубина проникновения составляла ~ 1.5 мкм, поверхностная концентрация галлия не превышала $5 \cdot 10^{14}$ см $^{-3}$). Были получены три образца A, B и C:

A — исходный образец был дырочным (фоновая примесь — бор, $p=2\cdot 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$); после диффузионного легирования галлием тип проводимости и концентрация носителй тока не изменились; согласно [2,7] уровень Ферми закреплен вблизи вершины валентной зоны и все центры цинка находятся в состоянии [Zn] 0 ;

B — исходный образец был электронным (фоновая примесь — фосфор, $n=2\cdot 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$); после диффузионного легирования галлием тип проводимости и концентрация носителей тока не изменились; согласно [2,7]

2* 275



I. Эмиссионные мессбауэровские спектры примесных атомов 67 Ga(67 Zn) в кремнии при 4.2 K для образцов A (спектр отвечает центрам $[Zn]^{0}$), B (спектр отвечает центрам $[Zn]^{=}$) и C (спектр отвечает присутствию $[Zn]^{=}$ и $[Zn]^{0}$). II. Расчетные мессбауэровские спектры 67 Zn для образцов A, B и C при U < 0. Показаны положения спектров центров $[Zn]^{0}$ и $[Zn]^{=}$. III. расчетные мессбауэровские спектры 67 Zn для образцов A, B и C при U > 0. Показаны положения спектров центров $[Zn]^{0}$, $[Zn]^{-}$ и $[Zn]^{=}$. Скоростная шкала всех спектров приводится относительно спектра образца A.

уровень Ферми закреплен вблизи дна зоны проводимости и все центры цинка находятся в состоянии $[Zn]^=$;

С — исходный образец был электронным (фоновая примесь — фосфор, $n = 2 \cdot 10^{16} \,\mathrm{cm}^{-3}$); вначале было проведено диффузионное легирование образца цинком (в вакуумированных кварцевых ампулах из газовой фазы при 1080°C в течение 60 ч с последующим снятием с поверхности слоя ~ 100 мкм концентрация цинка в образце была $1.5 \cdot 10^{16} \, \text{cm}^{-3}$ [2]), так что низкоомный исходный образец (~ 0.3 Ом · см) стал высокоомным $(\sim 10^4\,{\rm Om}\cdot{\rm cm})$ без изменения типа проводимости; затем было проведено диффузионное легирование галлием, причем после этого тип проводимости и концентрация носителей тока не изменились; согласно [2] уровень Ферми закреплен вблизи уровня $E_1 = 0.55 \, \mathrm{эB}$, так что центры цинка присутствуют преимущественно в состоянии [Zn]-; согласно [7] уровень Ферми закреплен между уровнями $E_1 = 0.316$ и $E_2 = 0.167$ эВ и центры цинка присутствуют в виде $[Zn]^0$ и $[Zn]^=$.

Мессбауэровские спектры 67 Ga(67 Zn) измерялись при 4.2 K с поглотителем 67 ZnS (поверхностная плотность $1000\,\mathrm{mr/cm^2}$ по изотопу 67 Zn). Спектры образцов A (спектр A) и B (спектр B) представляли собой одиночные линии, причем переход от дырочного к электронному образцу приводит к сдвигу центра тяжести спектра S в область положительных скоростей (см. рисунок, I). Очевидно, спектр A отвечает нейтральным центрам $[^{67}$ Zn] 0 , а спектр B — двукратно ионизованным центрам $[^{67}$ Zn] $^{=}$. При равенстве температуры измерения спектров величина S определяется

$$S = -(9/16)(k\Delta\theta/Mc^2) + \alpha\Delta\rho(0),$$

где k — постоянная Больцмана, M — масса ядра-зонда, c — скорость света в вакууме, $\Delta\theta$ — разность температур Дебая двух образцов, α — калибровочная постоянная, $\Delta\rho(0)$ — разность релятивистских плотностей электронного заряда на ядрах 67 Zn в двух образцах.

Первый член в этом выражении описывает влияние допплеровского сдвига 2-го порядка в дебаевском приближении и, поскольку оба спектра относятся к примесным атомам цинка в матрице кремния, этим членом можно пренебречь. Второй член представляет собой изомерный сдвиг, появляющийся из-за разности электронной плотности на ядрах 67 Zn в двух образцах. Возрастание S при переходе от $[Zn]^0$ к $[Zn]^=$ свидетельствует о возрастании электронной плотности на ядрах 67 Zn и, следовательно, о локализации на мессбауэровском центре двух электронов.

Спектр образца C (спектр C) представляет собой наложение спектров A и B (см. рисунок, I). На рисунке, II, III приведены ожидаемые формы мессбауэровских спектров 67 Zn для случаев U < 0 и U > 0. Методика построения таких спектров описана в [8] и использованы расчеты электронной плотности для различных электронных конфигураций цинка [9,10]. Сравнение экспериментальных (рисунок, I) и расчетных (рисунок, II, III) мессбауэровских спектров однозначно свидетельствует в пользу того, что для двухэлектронных центров цинка в кремнии величина U < 0.

Следует отметить, что спектры, отвечающие центрам $[Zn]^0$ и $[Zn]^=$, уширены (для спектра $Cu(^{67}Ga)$ с поглотителем ZnS ширина спектральной линии на полувысоте $\Gamma=2.6(3)$ мкм/с [11], тогда как для спектров на рисунке, I получено $\Gamma=5.0(5)$ мкм/с). Такое значительное уширение спектров свидетельствует об отличии локальной симметрии примесных атомов цинка от кубической и может интерпретироваться как доказательство "нецентральности" центров цинка в решетке кремния.

Таким образом, показано, что примесные атомы цинка в кремнии являются двухэлектронными акцепторными центрами с отрицательной корреляционной энергией, причем локальная симметрия центров $[Zn]^0$ и $[Zn]^=$ не является кубической.

Список литературы

- [1] C.S. Fuller, F.J. Morin. Phys. Rev., 103, 379 (1957).
- [2] R.O. Carlson. Phys. Rev., 108, 1390 (1957).
- [3] G.W. Ludwig, H.H. Woodbury. Sol. St. Phys., 13, 223 (1962).
- [4] В.Б. Гинодман, П.С. Гладков, Б.Г. Журкин, Б.В. Корнилов. ФТП, 5, 2214 (1971).
- [5] H.E. Altnik, T. Gregorkiewicz, C.A. Ammerlaan. Sol. St. Commun., 75, 115 (1990).
- [6] N.T. Bagraev. Semicond. Sci. Technol., 9, 61 (1994).
- [7] N.T. Bagraev. Sol. St. Commun., 95, 365 (1995).
- [8] В.Ф. Мастеров, Ф.С. Насрединов, С.А. Немов, П.П. Серегин. ФТП, **31**, 291 (1997).
- [9] A. Svane, E. Antoncik. Phys. Rev. B, 34, 1944 (1986).
- [10] D.W. Mitchell, T.P. Das, W. Potzel, G.M. Kalvius, H. Karzel, W. Schiessl, M. Steiner, M. Kofferlein. Phys. Rev. B, 48, 16449 (1993).
- [11] A. Forster, W. Potzel, G.M. Kalvius. Z. Phys. B, 37, 209 (1980).

Редактор В.В. Чалдышев

Mössbauer's investigation of a zinc two-electron acceptor impurity in silicon

- F.S. Nasredinov, N.P. Seregin, P.P. Seregin,
- S.I. Bondarevskii

Abstract Tne 67 Ga(67 Zn) emission Mössbauer spectroscopy has shown that the zinc impurity in silicon is a two-electron acceptor with neutral $[Zn]^0$ and twofold ionized $[Zn]^=$ states only, their population depending on the Fermi level position. Broadening of the zinc spectra corresponds to some deviations of their local symmetry from the cubic one. Lack of the $[Zn]^-$ state in the spectra of partially compensated samples is an evidence in favour of the negative correlation energy of zinc centers.